

平成 27 年度第 3 回半導体エレクトロニクス部門委員会 第 2 回研究会
平成 27 年度第 3 回ナノ材料部門委員会 第 1 回研究会

主 催： 日本材料学会半導体エレクトロニクス部門委員会
日本材料学会ナノ材料部門委員会
期 日： 平成 27 年 11 月 21 日（土） 13：00～（予定）
会 場： 京都大学 桂キャンパス
A クラスター（A1 棟） 地下 1 階（A1-001 室）
〒615-8246 京都府京都市 西京区京都大学桂 京大桂キャンパス
A クラスター（A1 棟） A1-001 室
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/access/campus/map6r_k.html
参加費： 無料

半導体エレクトロニクス・ナノ材料関連の材料・デバイス応用に関する研究発表を広く募集します。とくに、若い研究者・学生の方から、最新の研究成果に関する内容のみならず、発表済みではあるが討論がまだ不十分であるような内容、研究途中の話題や未解決の問題点を含む内容など、材料の観点から広い範囲の研究討論を行うことで次のステップへの鍵が得られるような発表を歓迎いたします。

■半導体エレクトロニクス部門委員会の賞

優れた発表に対して下記の賞を授与します。ただし、事前の応募が必要です。詳しくは、下記をご参照の上、応募される方は講演申込時に、その旨をご記入ください。

学生優秀講演賞： 博士課程以下の課程に在学する学生が行った優れた研究発表に対して、学生優秀講演賞を授与します。

講演奨励賞： 若手研究者による優れた研究発表に対して、講演奨励賞を授与します。

■申込方法

講演を希望される方は、講演申込期日までに、半導体エレクトロニクス部門委員会ホームページの「研究会の予定（http://algainn.jsms.jp/?page_id=48）」からお申し込みの上、講演原稿送付期日までに講演原稿を投稿してください。

<講演申込内容>

- ・講演タイトル、著者名、所属、学生優秀講演賞・講演奨励賞への応募の有無

<講演原稿作成要領>

- ・A4 サイズ 1-4 枚以内（図、表、写真を含む）、日本語または英語
- ・1 枚目の最初にタイトル、著者名、所属をセンタリングして記入
- ・pdf ファイル

■講演申込期日： 平成 27 年 10 月 30 日（金）

■講演原稿送付期日： 平成 27 年 11 月 15 日（日）

■講演プログラム

プログラムは 11 月上旬に公開予定です。

<招待講演> 織田真也 氏（株）FLOSFIA 最高技術責任者(CTO)
「酸化ガリウム（ α -Ga₂O₃）を用いた超低抵抗パワーデバイス開発」(仮)

■問合せ先

京都大学大学院工学研究科

金子 健太郎

E-mail: ken-kaneko [a_t] kuee.kyoto-u.ac.jp は@に置き換えてください。